



济南市半导体元件实验所

肖特基二极管系列产品

2DK35200T 型硅肖特基开关整流二极管

1 特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 TO-254 型金属封装。

具有正向压降低、正向导通损耗小，体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V，TO-254 型封装典型重量 8.5g。



TO-254 型

2 质量等级及执行标准

G+ G 级：Q/RB1008QZ、QZJ840611；

3 最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型号	I_{FM}^{a} $T_c=110^\circ\text{C}$	V_{RM}	V_{RWM}	I_{FSM}^{b} $t_p=8.3\text{ms}, T_c=25^\circ\text{C}$	T_j	T_{stg}	$R_{th(jc)}$
2DK35200T	35	200	180	280	-65~150	-65~150	2.0

^a T_c 超过 110°C 时，按 $0.875\text{A}/^\circ\text{C}$ 线性地降额。

4 主要电特性

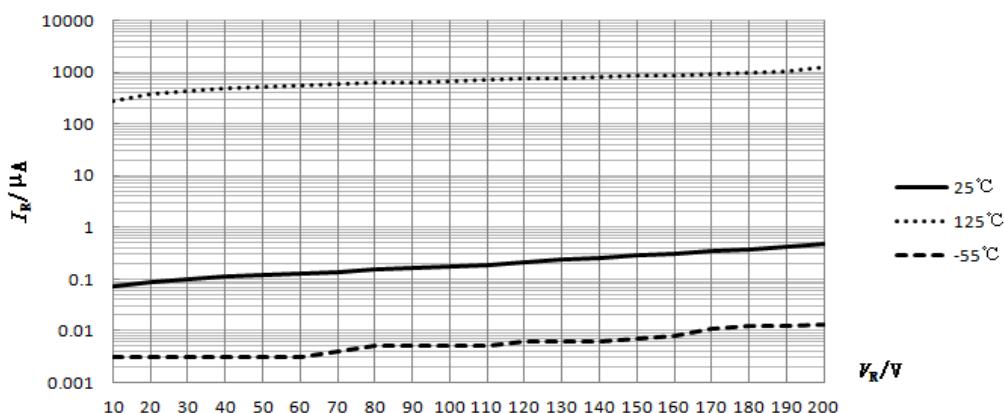
主要电特性 ($T_c=25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$) 见表 3。

表 3 主要电特性

序号	符号 (单位)	测试条件	规范值
1	正向压降 V_{FM1}	$T_c=25^\circ\text{C}, I_F=I_{FM} \text{ A}$	$\leq 0.92\text{V}$
2	正向压降 V_{FM2}	$T_c=-55^\circ\text{C}, I_F=I_{FM} \text{ A}$	$\leq 1.70\text{V}$
3	反向电流 I_{R1}	$T_c=25^\circ\text{C}, V_R=0.8 V_{RWM}\text{V}$	$\leq 10 \mu\text{A}$
4	反向电流 I_{R2}	$T_c=125^\circ\text{C}, V_R=0.8 V_{RWM}\text{V}$	$\leq 1\text{mA}$

5 特性曲线

5.1 不同温度、不同电压下的反向电流曲线

图 1 I_R-V_R 特性曲线



济南市半导体元件实验所

肖特基二极管系列产品

5.2 不同温度、不同电流下的正向电压曲线

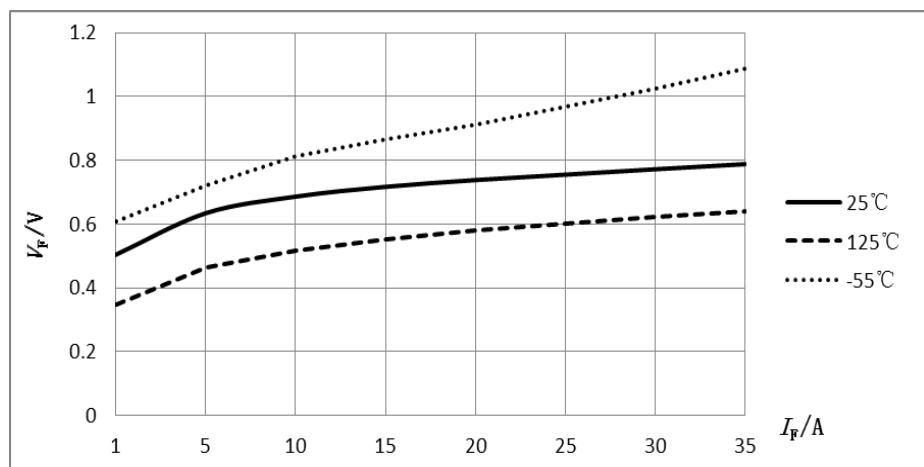
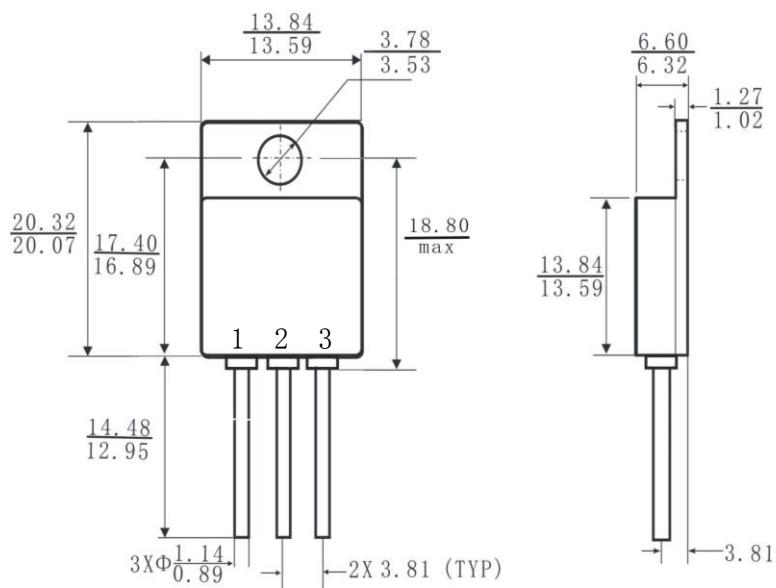


图 2 V_F — I_F 特性曲线

6 外观尺寸 (T0-254 型)

单位: mm



引出端电极: 1-阳极 2-阴极 3-阳极

图 3 T0-254 外形尺寸